

REC'D 14 JAN 2000

PCT/JP99/06428

JP99/6428

WIPO PCT
本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT
09/830949

17.11.99

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

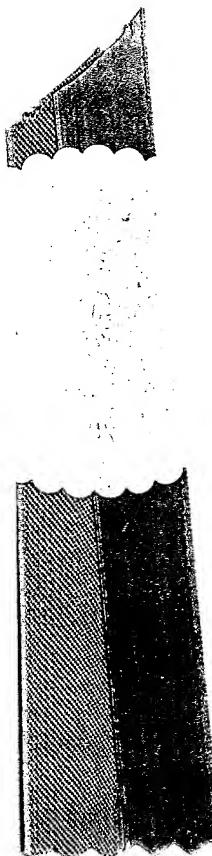
1999年 8月18日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第231931号

出願人
Applicant(s):

イビデン株式会社



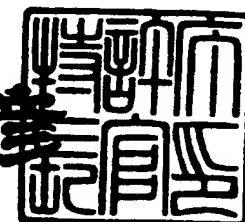
**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年12月24日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆



出証番号 出証特平11-3089769

【書類名】 特許願

【整理番号】 111250

【提出日】 平成11年 8月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 1/34

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大垣北工場内

【氏名】 伊藤 均

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大垣北工場内

【氏名】 岩田 義幸

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大垣北工場内

【氏名】 広瀬 直宏

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大垣北工場内

【氏名】 川出 雅徳

【特許出願人】

【識別番号】 000000158

【住所又は居所】 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

【氏名又は名称】 イビデン株式会社

【代表者】 岩田 義文

【代理人】

【識別番号】 100095795

【住所又は居所】 名古屋市中区上前津2丁目1番27号 堀井ビル3階

【弁理士】

【氏名又は名称】 田下 明人

【選任した代理人】

【識別番号】 100098567

【住所又は居所】 名古屋市中区上前津2丁目1番27号 堀井ビル3階

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 壮祐

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 34616号

【出願日】 平成11年 1月 4日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 97649号

【出願日】 平成11年 4月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 054874

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9401314

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パッケージ基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、

前記基板上に導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドは有機樹脂絶縁層で被覆されると共に、該有機樹脂絶縁層には、前記パッドを部分的に露出させる開口が形成されてなり、

前記開口から露出されるパッドには、前記導電性ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項2】 基板に他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、

前記基板上に、導電性接続ピンを固定するためのパッドであって、該導電性接続ピンを固定するための本体部と当該本体部の周縁に配設された延在部とからなるパッドが形成され、

前記パッドの延在部は有機樹脂絶縁層で被覆されると共に、該有機樹脂絶縁層には、前記パッドの本体部を露出させる開口が形成されてなり、

前記開口から露出されるパッドの本体部には、前記導電性ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項3】 前記基板が導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルトアップ基板であることを特徴とする請求項1又は2に記載のパッケージ基板。

【請求項4】 前記パッドの直径は、開口部の直径の1.02~100倍であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項5】 導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、

前記ビルドアップ基板の最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続

ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドは、バイアホールを介して内層の導体層に接続されるとともに、前記パッドに前記導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項6】 導体層が形成されたコア基板の両面に導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るために前記導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、

前記ビルドアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドはバイアホールを介して前記コア基板の導体層に接続されるとともに、当該パッドには前記導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項7】 導体層を備えたスルーホールが形成されてなるコア基板の両面に、導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るために導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、

前記ビルドアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドは、前記スルーホールの導体層とバイアホールを介して接続されているとともに、当該パッドには前記導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項8】 前記パッドは、少なくとも一つ以上のバイアホールを介して内層の導体層に接続していることを特徴とする請求項5ないし7のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項9】 前記パッドは、リング状のバイアホールを介して内層の導体層に接続していることを特徴とする請求項5ないし8のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項10】 前記パッドは、少なくとも二層以上に設けられたバイアホ

ールを介して内層の導体層と接続していることを特徴とする請求項5ないし9のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項11】 前記最外層の導体層は、パッドを部分的に露出させる開口部が形成された有機樹脂絶縁層で被覆され、前記開口部から露出したパッドに前記導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とする請求項5ないし10のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項12】 前記パッドの直径は、前記開口部の直径の1.02~1.0倍であることを特徴とする請求項11に記載のパッケージ基板。

【請求項13】 前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部とかなり、前記固定部がパッドに固定されていることを特徴とする請求項1ないし12のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項14】 前記導電性接着剤は、融点が180~280℃であることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項15】 前記導電性接着剤は、スズ、鉛、アンチモン、銀、金、銅が少なくとも1種類以上で形成されていることを特徴とする請求項1ないし14のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項16】 前記導電性接着剤は、Sn/Pb、Sn/Sb、Sn/Ag、Sn/Sb/Pbの合金であることを特徴とする請求項1ないし15のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、導電性接続ピンが固定された樹脂パッケージ基板に関する。

【0002】

【従来の技術】

ICチップ等をマザーボード又はデータボードへ接続するためのパッケージ基板は、近年、信号の高周波数化に伴い、低誘電率、低誘電正接が求められるようになった。そのため、基板の材質もセラミックから樹脂へと主流が移りつつある。

【0003】

このような背景の下、樹脂基板を用いたプリント配線板に関する技術として、例えば、特公平4-55555号公報に、回路形成がなされたガラスエポキシ基板にエポキシアクリレートを層間樹脂絶縁層として形成し、続いて、フォトリソグラフィの手法を用いてバイアホール用開口を設け、表面を粗化した後、めっきレジストを設けて、めっきにより導体回路およびバイアホールを形成した、いわゆるビルトアップ多層配線板が提案されている。

【0004】

このようなビルトアップ多層配線板をパッケージ基板として使用する場合には、マザーボードやデータボードへ接続するための導電性接続ピンを取り付ける必要がある。

このピンはT型ピンと呼ばれ、図18に示すように柱状の接続部122と板状の固定部121とで側面視略T字形状に形成されており、接続部122を介してマザーボードのソケット等に接続するようになっている。この導電性接続ピン120は、ビルトアップ多層配線板の最外層の層間樹脂絶縁層200（又は、コア基板）の導体層をパッド16とし、このパッド16にハンダなどの導電性接着剤17を介して接着固定される。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した構造では、パッド16とその内層の層間樹脂絶縁層200との接着面積が小さいことに加え、金属製のパッドと樹脂絶縁層という全く異なる材質ため、両者の接着強度が充分でないという問題があった。そのため、信頼性試験としての高温と低温とを繰り返すヒートサイクル条件下で、パッケージ基板側とマザーボード又はデータボード側との熱膨張率差により、基板に反りや凹凸が生じた場合、パッド16と層間樹脂絶縁層200との界面で破壊が起こり、導電性接続ピン120がパッド16と共に基板から剥離する問題が見られた。また、当該導電性接続ピンを介してパッケージ基板をマザーボードへ装着する際、導電性接続ピンの位置と接続すべきマザーボードのソケットとの間に位置ずれがあると、接続部に応力が集中して導電性接続ピンがパッドとともに剥離する

ことがあった。ヒートサイクルの高温領域下またはICチップを実装する際の熱によって、導電性ピンが脱落、傾きを起こしたり、電気的接続が取れないこともあった。

【0006】

本発明は、このような問題点を解決するために提案されたものであって、導電性接続ピンが剥離し難い樹脂パッケージ基板を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは鋭意検討した結果、本発明に到達した。すなわち、請求項1の発明は、基板に他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されるパッケージ基板において、前記基板上に導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドは有機樹脂絶縁層で被覆されると共に、該有機樹脂パッドには、前記パッドを部分的に露出させる開口が形成されてなり、前記開口絶縁層には、前記パッドを部分的に露出させる開口が形成されてなり、前記開口絶縁層には、前記パッドには、前記導電性ピンが導電性接着剤を介して固定されてから露出されるパッドには、前記導電性ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術手段としている。

【0008】

請求項1の発明では、導電性接続ピンが固定されるパッドは、当該パッドを部分的に露出する開口部が設けられた有機樹脂絶縁層によって覆われる。従って、導電性接続ピンを介してパッケージ基板をマザーボード等の他の基板に取り付ける際などに、たとえば導電性接続ピンとマザーボードのソケットとの間に位置するズレなどがあって当該導電性接続ピンに応力が加わった場合や、ヒートサイクル条件の熱履歴で基板に反りなどを生じた場合でも、パッドが有機樹脂絶縁層で押さえられており、基板から剥離するのを防止できる。特に、金属性のパッドと樹脂絶縁層という全く異なる材質同士の接着で、充分な接着力を得難い場合も、パッド表面から有機樹脂絶縁層で覆うことで、高い剥離強度を付与することができる。

【0009】

また、請求項1の発明において、パッドの大きさは、当該パッドが現れる有機樹脂絶縁層の開口部よりやや大きくすることが重要である。それにより、パッド

が開口部から部分的に露出する。すなわち、パッドの周縁が有機樹脂絶縁層で被われる所以である。パッドの大きさは、その直径が当該パッドを露出する有機樹脂絶縁層の開口部の直径の、1.02から100倍とするのがよい。パッドの直径が、開口部の直径の1.02倍未満では、パッドの周囲を有機樹脂絶縁層で確実に押さえきることができず、導電性接続ピンの剥離を防止できない。また、100倍より大きくすると、導体層の高密度化を阻害するからである。具体的には、有機樹脂絶縁層に設けられた開口部の直径を100から1,500μmとしたとき、パッドの直径を110から2,000μmとする。

【0010】

請求項2の発明では、基板に他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、前記基板上に、導電性接続ピンを固定するためのパッドであって、該導電性接続ピンを固定するための本体部と当該本体部の周縁に配設された延在部とからなるパッドが形成され、前記パッドの延在部は有機樹脂絶縁層で被覆されると共に、該有機樹脂絶縁層には、前記パッドの本体部を露出させる開口が形成されてなり、前記開口から露出されるパッドの本体部には、前記導電性ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術的特徴とする。

【0011】

請求項2では、パッドの周縁に配設された延在部が有機樹脂絶縁層により覆われる。このため、導電性接続ピンに応力が加わった際にも、パッドが有機樹脂絶縁層により押さえられるため、基板から剥離することが防止できる。一方、パッドの本体部は、有機樹脂絶縁層の開口により露出しており、有機樹脂絶縁層とパッド部の本体部とは接觸していないため、該有機樹脂絶縁層とパッド部の本体部と接觸によるクラックが発生することがない。

【0012】

請求項5の発明は、導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、前記ビルドアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するた

めのパッドを形成し、前記パッドを、バイアホールを介して内層の導体層に接続するとともに、前記パッドに導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定していることを技術手段としている。

【0013】

請求項5の発明では、パッドがバイアホールを介して内層の導体層と接合しているので、パッドと基板との接触面積が増え、両者が強固に接合される。また、前記したように、請求項1の発明では、導電性接続ピンが固定されるパッドとそのパッドが接着する層間樹脂絶縁層は、異素材間の接着となっているのに対し、請求項5で示した発明では、パッドは内層の導体層と接続する。そのため、両者は金属同士の接続となって、接続がより確実となるとともに、パッドの剥離強度が高められる。

【0014】

また、パッドを一つ以上のバイアホールを介して内層の導体層と接続してもよい。パッドの接着面積をさらに増して、より剥離しにくい構造とすることができるからである。なお、パッドをバイアホールを介して内層の導体層に接続する場合、バイアホールはそのパッドの周辺部分に配置するのが接続性を高める上で効果的である。そのため、バイアホールをリング状とし、そのリングを覆うようにパッドを設けてもよい。

【0015】

さらに、ビルトアップ基板において、導電性接続ピンが固定されるパッドは、2層以上のバイアホールを介して内層の導体層と接続するように構成してもよく、パッケージ基板の形状や種類によっては、この二層以上のバイアホールがそれ一つ以上のバイアホールよりもなってもよい。いずれも、パッドの表面積が増しているので、接着強度を高めるために有効だからである。更に、パッドが設けられるバイアホールを、パッドを部分的に露出させる開口部を有する有機樹脂絶縁層によって被覆すれば、パッドの剥離を確実に防止することができる。

【0016】

請求項6の発明では、導体層が形成されたコア基板に導体層と層間樹脂絶縁層が交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルトアップ基板に、他の

基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、前記ビルトアップ基板の最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドはバイアホールを介して前記コア基板の導体層に接続されるとともに、当該パッドには導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術手段とする。

【0017】

コア基板上の導体層は、コア基板となる樹脂基板の表面に粗化面（マット面）を介して強固に密着しており、このような導体層にパッドを接続させることにより、パッドが層間樹脂絶縁層から剥離しにくくなる。なお、パッドを一つ以上のバイアホールおよび二層以上のバイアホールを介して内層の導体層に接合する場合も、その内層の導体層はコア基板に設けたものであってよい。

【0018】

請求項7の発明は、導体層を備えたスルーホールが形成されてなるコア基板の両面に、導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルトアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、前記ビルトアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドは、前記スルーホールの導体層とバイアホールを介して接続されているとともに、当該パッドには導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術手段とする。

このパッケージ基板によれば、外部端子である導電性接続ピンと、当該導電性接続ピンが設けられる側の反対側面にある他の基板との配線長を短くすることができる。具体的には、コア基板において、スルーホール周辺のランドおよびスルーホール内に充填された樹脂充填材にバイアホールを介してパッドを接続する。また、スルーホールを導体層で被う、いわゆる蓋めつきを行い、この導体層に、バイアホールを介してパッドを接続することもできる。さらに、スルーホールのランドのみにバイアホールを介してパッドを接続してもよい。

【0019】

請求項14の発明では、導電性接着剤の融点が180～280℃であることに

よって、導電性接続ピンとの接着強度2.0Kg/pin以上が確保される。この強度は、ヒートサイクルなどの信頼性試験後、あるいは、ICチップの実装の際に要する熱を加えた後でも、その強度の低下が少ない。180°C未満の場合は、接着強度も2.0Kg/pin前後であり、場合によっては、1.5Kg/pin程度しか出ない。また、ICチップ実装の加熱によって、導電性接着剤が溶解してしまい、導電性接続ピンの脱落、傾きを起こしてしまった。280°Cを越える場合は、導電性接着剤の溶解温度に対して、樹脂層である樹脂絶縁層、ソルダーレジスト層が溶けてしまう。特に、望ましい温度は、200~260°Cである。その温度の導電性接着剤であることが、導電性接続ピンの接着強度のバラツキも少くなり、実際に加わる熱がパッケージ基板を構成する樹脂層への損傷もないからである。

【0020】

請求項15の発明では、導電性接着剤は、スズ、鉛、アンチモン、銀、金、銅が少なくとも1種類以上で形成されていることによって、前述の融点を有する導電性接着剤を形成することができる。特に、スズ-鉛あるいはスズ-アンチモンが少なくとも含有されている導電性接着剤が、前述の融点の範囲を形成させることができ、熱によって融解しても、再度、固着し易く導電性接続ピンの脱落、傾きを引き起こさない。

【0021】

前記導電性接着剤は、Sn/Pb、Sn/Sb、Sn/Ag、Sn/Sb/Pbの合金であることによって、特に、接着強度も2.0Kg/pinであり、そのバラツキも小さく、ヒートサイクル条件下やICチップの実装の熱によっても、導電性接続ピンの接着強度の低下もなく、ピンの脱落、傾きを引き起こさず、電気的接続も確保されている。

【0022】

【発明の実施の形態】

次に、図1ないし図8に従い、第1実施例のパッケージ基板を、ビルトアップ基板の製造方法とともに説明する。以下の方法は、セミアディティブ法によるものであるが、フルアディティブ法を採用してもよい。

【0023】

[第1実施例]

(1) まず、基板の表面に導体層を形成したコア基板を作成する。コア基板としては、ガラスエポキシ基板、ポリイミド基板、ビスマレイミドートリアジン樹脂基板などの樹脂絶縁基板の両面に銅箔8を貼った銅張積層板を使用することができる(図1(a)参照)。銅箔8は、片面が粗化面(マット面)となっており、樹脂基板に強固に密着している。この基板に、ドリルで貫通孔を設けた後、無電解めっきを施しスルーホール9を形成する。無電解めっきとしては銅めっきが好ましい。引き続き、めっきレジストを形成し、エッチング処理して導体層4を形成する。なお、銅箔の厚付けのためにさらに電気めっきを行ってもよい。この電気めっきにも銅めっきが好ましい。また、電気めっきの後、導体層4の表面およびスルーホール9の内壁面を粗面4a, 9aとしてもよい(図1(b)参照)。

【0024】

この粗化処理方法としては、例えば、例えば黒化(酸化)－還元処理、有機酸と第2銅錯体の混合水溶液によるスプレー処理、Cu-Ni-Pの針状合金めっきによる処理などが挙げられる。

【0025】

次に、得られた基板を水洗してから乾燥する。その後、基板表面の導体層4間およびスルーホール9内に樹脂充填材10を充填し、乾燥させる(図1(c))。引き続き、基板両面の不要な樹脂充填材10をベルトサンダー研磨などで研削し、導体層4を露出させ、樹脂充填材10を本硬化させる。導体層4間およびスルーホール9による凹部を埋めて基板を平滑化する(図1(d)参照)。

【0026】

次に、露出した導体層4の表面に粗化層11を再度設ける(図2(a)参照)。なお、図2(a)中の円で示す部分は、粗化層11が設けられた導体層4を拡大して示している。この粗化層11は、先に述べたようなCu-Ni-Pの針状あるいは多孔質状合金層により形成されていることが望ましいが、この他にも黒化(酸化)－還元処理やエッチング処理で粗化層を形成することもできる。Cu

-Ni-P針状または多孔質状合金層による場合、荏原ユージライト製商品名「インタープレート」により、また、エッチング処理は、メック社製商品名「M E C etch Bond」により行なうことが望ましい。

【0027】

(2) 上記(1)で作成した導体層4を有する配線基板の両面に樹脂層2a、2bからなる樹脂絶縁層2を形成する(図2(b)参照)。この樹脂絶縁層2は後述するようにパッケージ基板の層間樹脂絶縁層200として機能する。

上記樹脂絶縁体層(以下、層間樹脂絶縁層200)を構成する材料としては、例えば、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂またはこれらの複合樹脂などが挙げられる。層間樹脂絶縁層2として、無電解めっき用接着剤を用いることが望ましい。この無電解めっき用接着剤は、硬化処理された酸あるいは酸化剤に可溶性の耐熱性樹脂粒子が、酸あるいは酸化剤に難溶性の未硬化の耐熱性樹脂中に分散されてなるものが最適である。後述するように酸、酸化剤の溶液で処理することにより、耐熱性樹脂粒子が溶解除去されて、表面に蛸つぼ状のアンカーからなる粗化面を形成できるからである。

【0028】

上記無電解めっき用接着剤において、特に硬化処理された前記耐熱性樹脂粒子としては、①平均粒径が10μm以下の耐熱性樹脂粉末、②平均粒子径が相対的に大きな粒子と平均粒子径が相対的に小さな粒子を混合した粒子が望ましい。これらはより複雑なアンカーを形成できるからである。

【0029】

使用できる耐熱性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂(ビスA型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂など)、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂と熱可塑性樹脂との複合体等が挙げられる。複合させる熱可塑性樹脂として、ポリエーテルスルfonyl(PEs)、ポリサルfonyl(PSF)、ポリフェニレンサルfonyl(PPS)、ポリフェニレンサルファイド(PPes)、ポリフェニルエーテル(PPe)、ポリエーテルイミド(PI)などを使用できる。また、酸や酸化剤の溶液に溶解する耐熱性樹脂粒子としては、たとえば、エポキシ樹脂(特にアミン系硬化剤で硬化させたエポキシ樹脂がよい)、アミノ樹脂や、ポ

リエチレン系ゴム、ポリブタン系ゴム、ポリブタジエンゴム、ポリブチンゴムなどのゴムが挙げられる。層間絶縁層は、塗布、樹脂フィルムを加熱圧着などを施して形成される。

【0030】

(3) 次に、層間樹脂絶縁層2に、導体層4との電気接続を確保するためのバイアホール形成用開口6を設ける(図2(c)参照)。

上述した無電解めっき用接着剤を用いる場合には、バイアホール形成のための円パターンが描画されたフォトマスクを載置し、露光、現像処理してから熱硬化することで開口6を設ける。一方、熱硬化性樹脂を用いた場合には、熱硬化したのちレーザー加工することにより、上記層間樹脂絶縁層にバイアホール用の開口6を設ける。また、樹脂フィルムを貼り付けて層間絶縁層を形成させた場合には、炭酸、YAG、エキシマ、UVレーザ等のレーザで加工することにより、バイアホール用の開口を設ける。必要に応じて過マンガン酸などによるディップあるいは、プラズマなどのドライエッティングによってデスマニヤ処理をする。

【0031】

(4) 次に、バイアホール形成用開口6を設けた層間樹脂絶縁層2の表面を粗化する(図2(d)参照)。層間樹脂絶縁層2に無電解めっき用接着剤を用いた場合、この無電解めっき用接着剤層の表面に存在する耐熱性樹脂粒子を酸または酸化剤で溶解除去することにより、無電解めっき用接着剤層2の表面を粗化して、蛸壺状のアンカーを設ける。

【0032】

ここで、上記酸としては、例えば、リン酸、塩酸、硫酸などの強酸、または蟻酸や酢酸などの有機酸を用いることができる。特に、有機酸を用いるのが望ましい。これは、粗化処理した場合に、バイアホール用開口6から露出する金属導体層4を腐食させにくいからである。

一方、上記酸化剤としては、クロム酸、過マンガン酸塩(過マンガン酸カリウムなど)の水溶液を用いることが望ましい。

【0033】

前記粗化は、表面の最大粗度R_{max}0.1~20μmがよい。厚すぎると粗

化面自体が損傷、剥離しやすく、薄すぎると密着性が低下するからである。

【0034】

(5) 次に、層間樹脂絶縁層2の表面を粗化した配線基板に、触媒核を付与する。触媒核の付与には、貴金属イオンや貴金属コロイドなどを用いることが望ましく、一般的には塩化パラジウムやパラジウムコロイドを使用する。なお、この触媒核を固定するために、加熱処理を行うことが望ましい。このような触媒核にはパラジウムが好適である。

【0035】

(6) 続いて、粗化し触媒核を付与した層間樹脂絶縁層2の全面に無電解めっきを施し、無電解めっき膜12を形成する(図3(a)参照)。この無電解めっき膜12の厚みは、0.1~5μmが好ましい。

【0036】

次に、無電解めっき膜12の表面にめっきレジスト3を形成する(図3(b)参照)。形成した無電解めっき膜12上に感光性樹脂フィルム(ドライフィルム)をラミネートし、この感光性樹脂フィルム上に、めっきレジストパターンが描画されたフォトマスク(ガラス基板がよい)を密着させて載置し、露光し現像処理することによりめっきレジスト3を形成できる。

【0037】

(7) 次に、電気めっきを施し、無電解めっき膜12上のめっきレジスト非形成部に電気めっき膜を形成し、導体層5とバイアホール7を形成する。その厚みは5~20μmがよい。この電気めっきには、銅めっきが好ましい。

また、電気めっき後に、電解ニッケルめっき、無電解ニッケルめっき、またはスパッタから選ばれる少なくとも1の方法により、ニッケル膜14を形成する(図3(c)参照)。このニッケル膜14上にはCu-Ni-Pからなる合金めっきが析出しやすいからである。また、ニッケル膜はメタルレジストとして作用するため、その後の工程でも過剰エッチングを防止するという効果を奏する。

【0038】

(8) 続いて、めっきレジスト3を除去した後、そのめっきレジスト下に存在していた無電解めっき膜12を、硫酸と過酸化水素の混合液や過硫酸ナトリウム

、過硫酸アンモニウムなどの水溶液からなるエッティング液にて除去し、無電解めっき膜12、電解めっき膜13及びニッケル膜14の3層からなる独立した導体層5とバイアホール7を得る（図3（d）参照）。なお、非導体部分に露出した粗化面上のパラジウム触媒核は、クロム酸、硫酸過水などにより溶解除去する。

【0039】

（9）次に、導体層5とバイアホール7の表面に粗化層11を設け、さらに層間樹脂絶縁層2として先に述べた無電解めっき用接着剤の層を形成する。（図4（a）参照）。

【0040】

（10）この層間樹脂絶縁層2に、バイアホール用開口6を設けるとともに、層間樹脂絶縁層2の表面を粗化する。（図4（b）参照）。

【0041】

（11）つづいて、この粗化した層間樹脂絶縁層2の表面に触媒核を付与した後、無電解めっき膜12を形成する（図4（c）参照）。

【0042】

（12）無電解めっき膜12の表面にめっきレジスト3を形成し、先に述べたように、めっきレジスト3の非形成部に電気メッキ膜13、ニッケルめっき膜14を形成する（図4（d）参照）。

【0043】

（13）めっきレジスト3を除去し、めっきレジスト下の無電解めっき膜12を除去し、導体層（導電性接続ピンを固定するパッド16となる導体層を含む）5、およびバイアホール7を設け、片面3層の6層のビルトアップ基板を得る（図5参照）。

【0044】

（14）このようにして得られたビルトアップ基板の導体層5及びバイアホール7に粗化層11を形成し、パッド16を部分的に露出させる開口部18を有する有機樹脂絶縁層15で被覆する（図6参照）。有機樹脂絶縁層の厚さは5～40μmがよい。薄すぎると絶縁性能が低下し、厚すぎると開口し難くなるうえ半田と接触し、クラックなどの原因となるからである。

【0045】

この有機樹脂絶縁層を構成する樹脂としては、種々のものが使用でき、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂のアクリレート、ノボラック型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂のアクリレートをアミン系硬化剤やイミダゾール硬化剤で硬化させた樹脂を使用できる。

【0046】

このような構成の有機樹脂絶縁層は、鉛のマイグレーション（鉛イオンが、有機樹脂絶縁層内を拡散する現象）が少ないといった利点を有する。しかも、この有機樹脂絶縁層は、耐熱性、耐アルカリ性に優れ、ハンダなどの導電性接着剤が溶融する温度（200℃前後）でも劣化しないし、ニッケルめっきや金めっきのような強塩基性のめっき液で分解することもない。

【0047】

ここで、上記ノボラック型エポキシ樹脂のアクリレートとしてはフェノールノボラックやクレゾールノボラックのグリシジルエーテルをアクリル酸やメタクリル酸などと反応させたエポキシ樹脂などを用いることができる。上記イミダゾール硬化剤は、25℃で液状であることが望ましい。液状であれば均一混合できるからである。

【0048】

このような液状イミダゾール硬化剤としては、1-ベンジル-2-メチルイミダゾール（品名：1B2MZ）、1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイミダゾール（品名：2E4MZ-CN）、4-メチル-2-エチルイミダゾール（品名：2E4MZ）を用いることができる。

【0049】

このイミダゾール硬化剤の添加量は、上記有機樹脂絶縁層の総固形分に対して1から10重量%とすることが望ましい。この理由は、添加量がこの範囲内にあれば均一混合がしやすいからである。上記有機樹脂絶縁層の硬化前組成物は、溶媒としてグリコールエーテル系の溶剤を使用することが望ましい。かかる組成物を用いた有機樹脂絶縁層は遊離酸素が発生せず、パッド表面を酸化させず、また人体に対する有害性も少ないからである。

【0050】

上記グリコールエーテル系溶剤としては、望ましくはジェチレングリコールジメチルエーテル (DMDG) およびトリエチレングリコールジメチルエーテル (DMTG) から選ばれるいずれか少なくとも1種を用いる。これらの溶剤は、30～50℃程度の加温により、反応開始剤であるベンゾフェノンやミヒラーケトンを完全に溶解させることができるからである。

このグリコールエーテル系の溶媒は、有機樹脂絶縁層の組成物の全重量に対して10～40重量%がよい。

【0051】

以上説明したような有機樹脂絶縁層の組成物には、そのほかに各種消泡剤やレベリング剤、耐熱性や耐塩基性の改善と可撓性付与のために熱硬化性樹脂、解像度改善のために感光性モノマーなどを添加することができる。例えば、レベリング剤としてはアクリル酸エステルの重合体からなるものがよい。また、開始剤としてはチバガイギー社製のイルガキュアI907、光増感剤としては日本化薬社製のDETX-Sがよい。さらに、有機樹脂絶縁層の組成物には色素や顔料を添加してもよい。配線パターンを隠蔽できるからである。この色素としてはフタロシアニングリーンを用いることが望ましい。

【0052】

添加成分としての上記熱硬化性樹脂としては、ビスフェノール型エポキシ樹脂を用いることができる。このビスフェノール型エポキシ樹脂には、ビスフェノールA型エポキシ樹脂とビスフェノールF型エポキシ樹脂があり、耐塩基性を重視する場合には前者が、低粘度化が要求される場合（塗布性を重視する場合）には後者がよい。

【0053】

また、これらの有機樹脂絶縁層組成物は、25℃で0.5から10Pa·s、より望ましくは1～10Pa·sがよい。ロールコータで塗布しやすい粘度だからである。

【0054】

(15) 前記開口部18内に金めっき膜、ニッケルめっき膜-金めっき膜など

の耐食金属である金属膜19の形成を行った後、パッケージ基板の下面側（ドータボード、マザーボードとの接続面）となる開口部16内に、導電性接着剤17としてハンダペーストを印刷する。半田ペースの粘度としては、50～400P aSの範囲で行うことがよい。さらに、導電性接続ピン100を適當なピン保持装置に取り付けて支持し、導電性接続ピン100の固定部101を開口部16内に当接させて、240～270℃でリフローを行い、導電性接着剤17に固定する（図7参照）。または、導電性接着剤をボール状等とし形成したものを開口部内に入れて、あるいは、導電性接続ピン100の板状の固定部側に接合させて導電性接続ピンを取り付けた後、リフローさせてもよい。また、図7において円で囲んで示した導電性接続ピン100を設けたパッド部分を、図8に拡大して示した。

なお、パッケージ基板310において、上面側の開口18には、ICチップなどの部品に接続可能なハンダバンプ230を設けた。

【0055】

本発明に用いられる導電性接続ピン100は、板状の固定部101とこの板状の固定部101の略中央に突設された柱状の接続部102とからなる、いわゆるT型ピンが好適に用いられる。板状の固定部101は、パッド16となるパッケージ基板の最外層の導体層5に導電性接着剤17を介して固定される部分であって、パッドの大きさに合わせた円形状や多角形状など適当に形成される。また、接続部102の形状は、他の基板の端子など接続部に挿入可能な柱状であれば問題なく、円柱・角柱・円錐・角錐など何でもよい。

[0056]

導電性接続ピン100の材質にも金属であれば限定ではなく、金・銀・銅・鉄・ニッケル・コバルト・スズ・鉛などの中から少なくとも1種類以上の金属で形成するのがよい。特に、鉄合金である、商品名「コバール」(Ni-Co-Fe)、ステンレスや、銅合金であるリン青銅が挙げられる。電気的特性および導電性接続ピンとしての加工性に優れているからである。また、この導電性接続ピンは、一種類の金属または合金で形成しても、腐食防止あるいは強度向上のために表面を他の金属層で被覆してもよい。さらに、セラミックなどの絶縁性物質で形成

し、その表面を金属層で被覆してもよい。

【0057】

導電性接続ピン100において、柱状の接続部102は直径が0.1～0.8mmで長さが1.0～10mm、板状の固定部101の直径は0.5～2.0mmの範囲とすることが望ましく、パッドの大きさや装着されるマザーボードのソケット等の種類などによって適宜に選択される。

【0058】

本発明のパッケージ基板に用いられる導電性接着剤17としては、ハンダ(スズ-鉛、スズ-アンチモン、銀-スズ-銅など)、導電性樹脂、導電性ペーストなどを使用することができる。導電性接着剤の融点が180～280℃の範囲のものを用いることがよい。それにより、導電性接続ピンの接着強度2.0Kg/pin以上が確保され、ヒートサイクル条件下やICチップの実装の際にかかる熱による導電性接続ピンの脱落、傾きがなくなり、電気的接続も確保されるのである。ハンダで形成するのが最も好ましい。導電性接続ピンとの接続強度に優れないとともに、熱にも強く、接着作業がやりやすいからである。

【0059】

導電性接着剤17をハンダで形成する場合、Sn/Pb=95/5、60/40などの組成よりなるハンダを使用するのが好適である。用いられるハンダの融点も180～280℃の範囲にあるものが好適である。特に望ましいのは200～260℃の範囲であるものがよい。それにより、導電性接続ピンの接着強度のバラツキも少なくなり、実装の際に加わる熱がパッケージ基板を構成する樹脂層を損傷しないからである。

【0060】

このパッド16は、図8に示すように、当該パッド16を部分的に露出させる開口部18が形成された有機樹脂絶縁層(スルーホール層)15により被覆されており、開口部18から露出したパッド16に導電性接着剤17を介して導電性接続ピン100の固定部101が固定されている。図から理解されるように、この有機樹脂絶縁層15は、パッド16の周囲を押さえるように被覆しているので、ヒートサイクル時や、パッケージ基板をマザーボードへ装着する際などに、導

電性接続ピン100に応力が加わっても、パッド16の破壊および層間樹脂絶縁層15との剥離を防止できる。また、金属と樹脂という異なった素材同士の接着においても剥離し難くなっている。なお、ここでは、層間樹脂絶縁層が形成された多層プリント配線板から成るパッケージ基板を例示したが、1枚の基板のみからなるパッケージ基板にも第1実施例の構成は適用可能である。

【0061】

a. 第1改変例

図17は、第1実施例の第1改変例に係るパッケージ基板319を示している。ここで、図17(A)は、パッケージ基板319の要部の断面図であり、図17(B)は、図17(A)のB矢視図である。ここで、図17(B)中のA-A断面が、図17(A)に相当する。図17(B)に示すように、ランド16は、導電性接続ピン100を取り付けるための円形の本体部16bと、該本体部16bの周縁に配設された延在部16aとからなり、該本体部16bには、更に信号線16cが接続されている。図8を参照して上述した例では、ランド16の周縁が層間樹脂絶縁層(有機樹脂絶縁層)15により押さえられていた。これに対して、第1改変例では、パッド(本体部16b)の周縁に配設された延在部16aが、ソルダーレジスト層15により覆われる。本体部16bは、ソルダーレジスト層15に設けられた開口部18により露出されている。

【0062】

この第1改変例においても、パッド(本体部16b)の周縁に配設された延在部16aがソルダーレジスト層15により覆われるため、導電性接続ピン100に応力が加わった際にも、基板から剥離することを防止できる。一方、パッドの本体部16bは、有機樹脂絶縁層15の開口部18により露出しており、有機樹脂絶縁層15とパッド部の本体部16aとは接触していないため、該有機樹脂絶縁層15とパッド部の本体部16aと接触により、当該有機樹脂絶縁層15側にクラックを発生させることがない。

【0063】

[第2実施例]

このパッケージ基板311は、基本的には図7および図8を参照して上述した

第1実施例と同様であるが、導電性接続ピン100を固定するパッド16を、バイアホール7を介して、最外層側層間樹脂絶縁層200の内層の導体層160(5)に接続する。この例では、有機樹脂絶縁層15によりパッド16は被覆しなかった(図9参照)。製造工程は、(1)から(14)までは第1実施例と全く同じであるため、以下の工程(15)から説明する。

【0064】

(15) バイアホール7内に、導電性接着剤となるハンダペースト(Sn/Sb=95:5)17を充填する。ここでは、有機樹脂絶縁層15の表面にマスク材(図示せず)を配置し密着させてハンダペーストを印刷し、最高270℃でリフロした。

(16) 導電性接続ピンのパッドへの固定は、第1実施例と同じである。

この例では、バイアホール7によってパッド16と基板との接着面積が大きくなっているので、パッド16の剥離強度を高めることができる。また、内層の導体層160は金属層であるので、同じ金属製のパッド16の接着性も良好で、剥がれにくい構造となっている。

【0065】

なお、パッドが接続する内層の導体層は、コア基板1に設けられていてよい。先に述べたように、コア基板上の導体層は粗化面を介してコア基板と強固に密着しているので、パッドをより剥離し難くすることができる。

【0066】

a. 第1改変例

基本的に第2実施例と同じであるが、パッド16を設けたバイアホール7を、そのパッドが部分的に露出する開口部18を有する有機樹脂絶縁層15によって被覆したパッケージ基板312である(図10参照)。このパッケージ基板312は、パッド16がバイアホール7に設けられ、しかもその表面を有機樹脂絶縁層15で覆っているので、パッド16と基板との剥離強度に優れている。

【0067】

b. 第2改変例

基本的に第1改変例と同じであるが、一の導電性接続ピン100を固定するパ

ッド16を、複数のバイアホール7を介して、層間樹脂絶縁層200の内層の導体層160に接続したパッケージ基板313である(図11(A)参照)。本例では、図11(B)に示すように、バイアホール7を円形に6つ配置し、各バイアホール7を覆うようにパッド16を形成した。図11(B)は、図11(A)をバイアホール7側から見たB矢視図である。なお、図11(B)に示すバイアホール7の位置では、断面で示した場合、図11(A)のような3つのバイアホール7は現れないが、図示の便宜上、向こう側のバイアホールを点線で示してある。

【0068】

c. 第3改変例

基本的に第2改変例と同じであるが、バイアホール7の形状を、図12(B)で示すようなリング状としたパッケージ基板314である(図12参照)。図12(B)は図12(A)のB矢視図である。

【0069】

第2改変例では複数のバイアホール7によって、また、第3改変例ではリング状のバイアホール7によって、基板との接着面積が更に大きくなっている。

【0070】

d. 第4改変例

基本的に図11に示して説明した第2改変例と同じであるが、内層の層間樹脂絶縁層200にも円形に配置した複数のバイアホール7を設け、パッド16が設けられる外層側バイアホール7と内層のバイアホール7とを接合したパッケージ基板315である(図13参照)。このパッケージ基板315では、複数のバイアホール7同士を結合しているので、パッド16が極めて剥がれ難くなっている。

【0071】

なお、先に述べたように、これら各改変例においても、パッドが設けられる内層の導体層はコア基板1に形成されたものであることが望ましい。コア基板上の導体層は、コア基板となる絶縁基板と粗化面(マット面)を介して強固に密着しており、このようなコア基板上の導体層に接続させることにより、パッド16が

層間樹脂絶縁層200から剥離し難くなる。

【0072】

[第3実施例]

基本的に第2実施例の第2改変例と同じであるが、パッド16を接続する内層の導体層をコア基板1のスルーホール9に設けた導体層（ランド91）とし、有機樹脂絶縁層15によりパッド16の周縁を覆ったパッケージ基板316である（図14参照）。図示されるように、スルーホール9のランド91およびスルーホール9内の樹脂充填材10に、バイアホール7を介してパッド16を接続している。

【0073】

つまり、パッド16は、バイアホール7を介してコア基板1の導体層に接続していることに特徴がある。コア基板1上の導体層は、コア基板となる絶縁基板と粗化面（マット面）を介して強固に密着しており、このようなコア基板上の導体層に接続させることにより、パッド16が層間樹脂絶縁層200から剥離し難くなる。また、スルーホール9とパッド16とがバイアホール7を介して接続されている。このため、外部端子である導電性接続ピン100と、該導電性接続ピン100該導電性接続ピン100が設けられる側の反対に位置するICチップ（半導体チップ）との間の配線長を短くできる。

【0074】

a. 第1改変例

基本的に第3実施例と同じであるが、スルーホール9に当該スルーホール9を覆う蓋めっきと呼ばれる導体層90を形成し、この導体層90にバイアホール7を介してパッド16を接続したパッケージ基板317である（図15参照）。

【0075】

b. 第2改変例

基本的に第3実施例と同じであるが、バイアホールを介して、スルーホール9のランド91のみにパッド16を接続したパッケージ基板318である（図16参照）。これらの例では、パッド16が、コア基板1表面の導体層4と接着して剥がれにくい構造となっているだけでなく、特にスルーホールのランド91と結

合させることで、基板裏面側との配線長を短くすることができる。

【0076】

【第4実施例】

基本的に第2実施例と同じであるが、ハンダをボール状にしたもの導電性接続ピンに取り付けて、その後、導電性接続ピンを配設した。

【0077】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、パッドと基板との接着強度を高めることができるので、導電性接続ピンおよび当該ピンが設けられるパッドの剥離防止に有効で、接続信頼性を向上させることができる。

【0078】

図19に実施例のパッケージ基板を評価した結果を示す。評価項目として、接合後の導電性接続ピンの最小の接着強度、加熱試験（仮想のIC実測状態の再現、ピンを配設した基板を250°Cにした窒素リフロー炉に通すことによる評価）、およびヒートサイクル条件下（130°C/3分+/-65°C/3分を1サイクルとして、10000サイクル実施）後の各々のピンの状態、最小接着強度、導通試験を行った。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1(a), 図1(b), 図1(c), 図1(d)は、本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図2】

図2(a), 図2(b), 図2(c), 図2(d)は、本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図3】

図3(a), 図3(b), 図3(c), 図3(d)は、本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図4】

図4(a), 図4(b), 図4(c), 図4(d)は、本発明の第1実施例に

係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図5】

本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図6】

本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図7】

本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図8】

図7において、導電性接続ピンをパッドに接続した部分を拡大した断面図である。

【図9】

本発明の第2実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図10】

第2実施例の第1改変例を示す断面図である。

【図11】

第2実施例の第2改変例を示す図であって、図11(A)はパッド部分の断面図、図11(B)は図11(A)のB矢視図である。

【図12】

第2実施例の第3改変例を示す図であって、図12(A)パッド部分の断面図、図12(B)は図12(A)のB矢視図である。

【図13】

第2実施例の第4改変例を示す断面図である。

【図14】

第3実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図15】

第3実施例の第1改変例を示す断面図である。

【図16】

第3実施例の第2改変例を示す断面図である。

【図17】

図17 (A) は、第1実施例の第1改変例を示す断面図であり、図17 (B) は、図17 (A) のB矢視図である。

【図18】

従来技術のパッケージ基板を示す断面図である。

【図19】

各実施例のパッケージ基板の評価結果を示す図表である。

【符号の説明】

- 1 コア基板
- 2, 200 層間樹脂絶縁層
- 3 めっきレジスト
- 4 導体層（下層）
- 4 a 粗化面
- 5 導体層（上層）
- 6 バイアホール用開口
- 7 バイアホール
- 8 銅箔
- 9 スルーホール
- 9 a 粗化面
- 9 1 スルーホールのランド
- 1 0 樹脂充填剤
- 1 1 粗化層
- 1 2 無電解めっき膜
- 1 3 電解めっき膜
- 1 4 ニッケルめっき層
- 1 5 有機樹脂絶縁層
- 1 6 パッド
- 1 6 a 延在部
- 1 6 b 本体部
- 1 7 導電性接着剤

18 開口部

100 導電性接続ピン

101 固定部

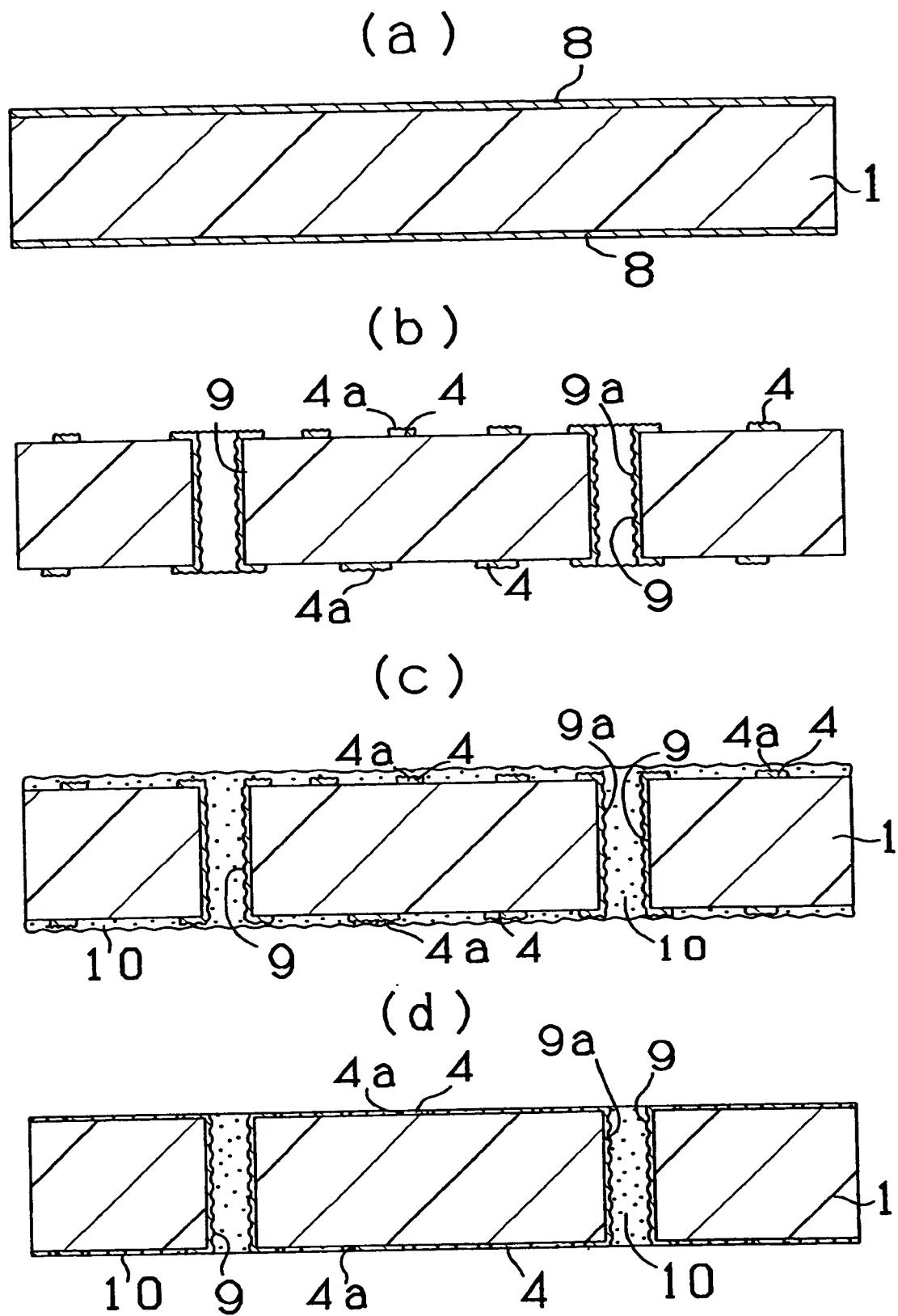
102 接続部

310, 311, 312, 313 パッケージ基板

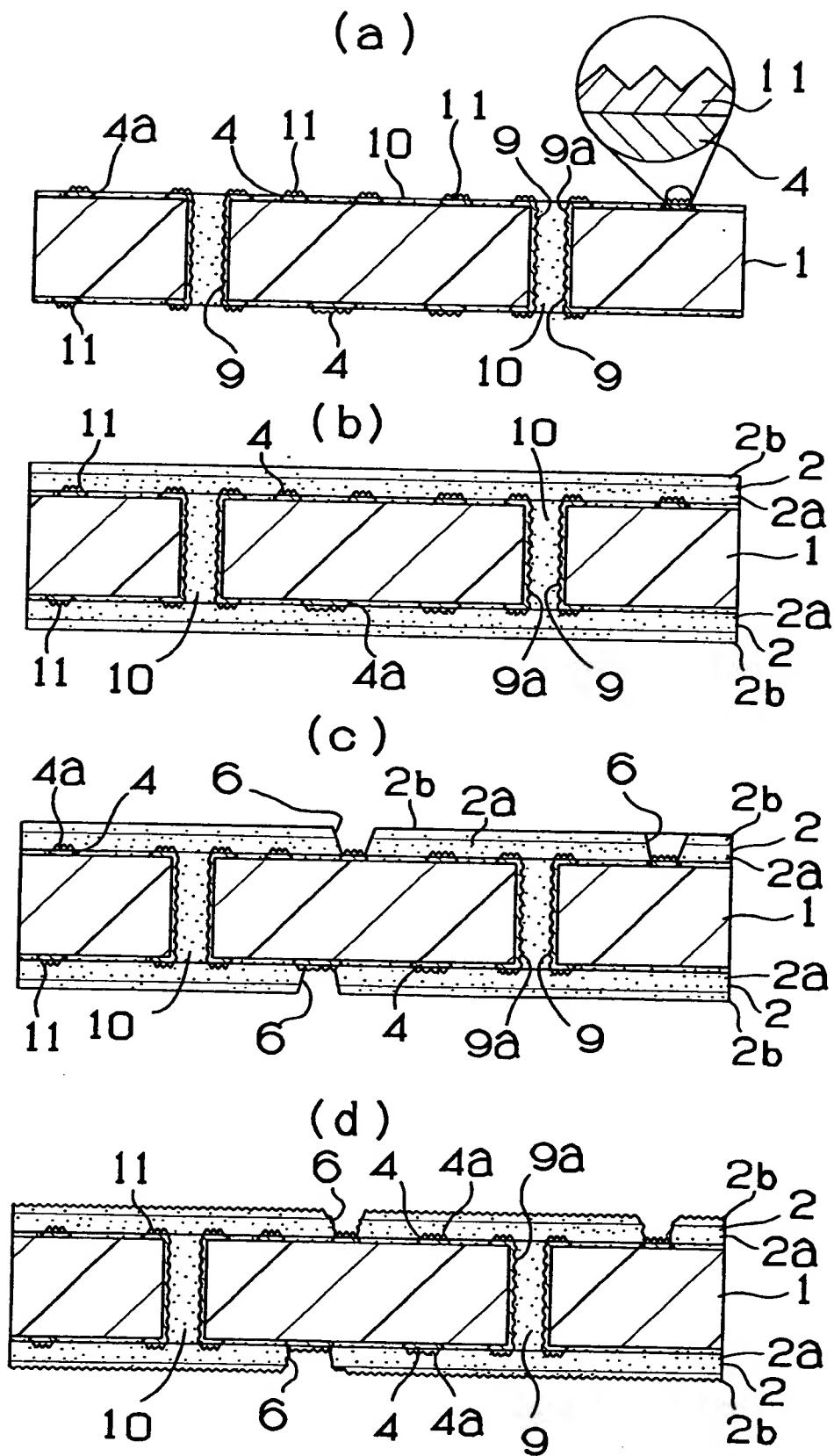
314, 315, 316, 317, 318 パッケージ基板

【書類名】図面

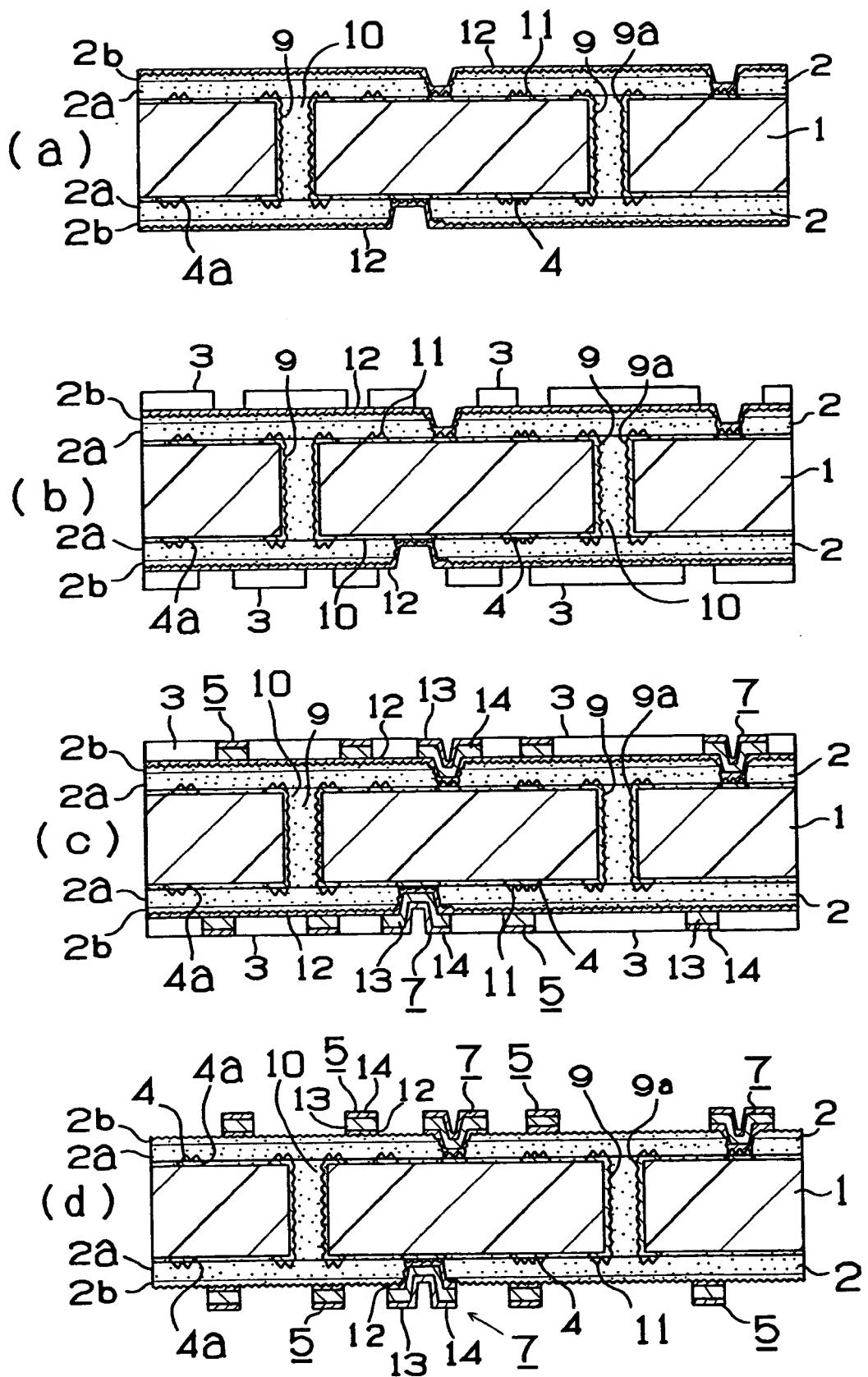
【図1】



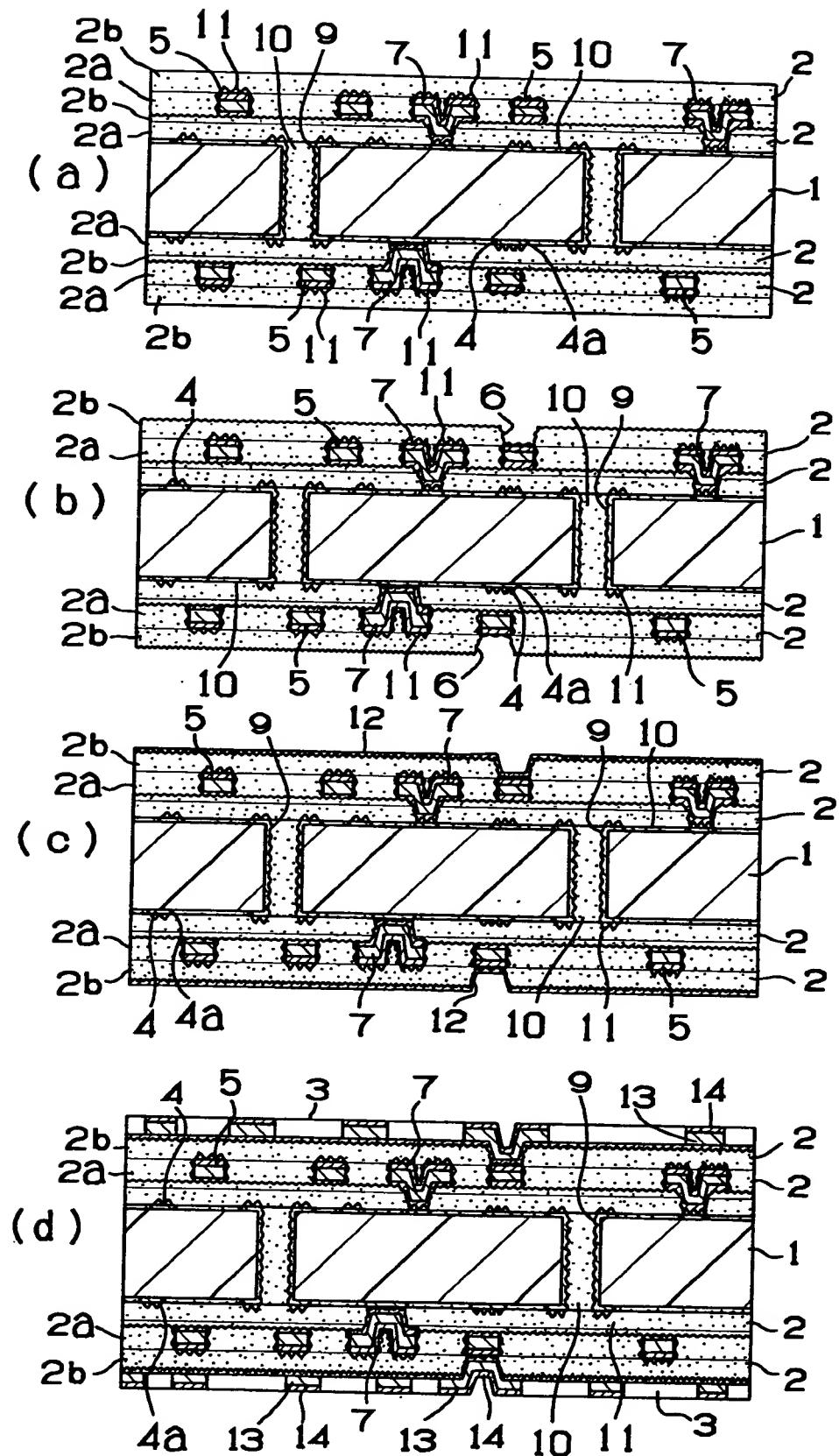
【図2】



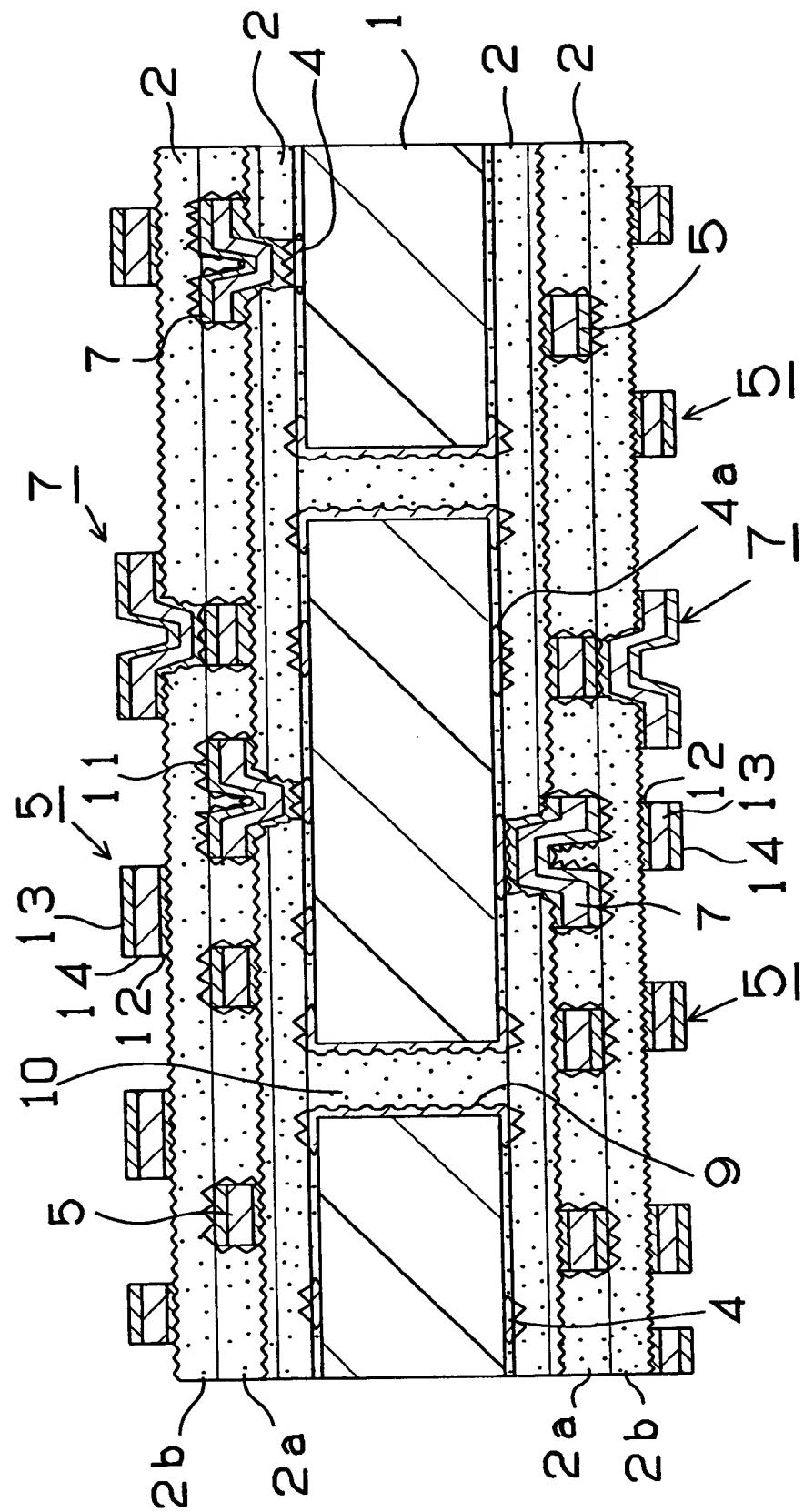
【図3】



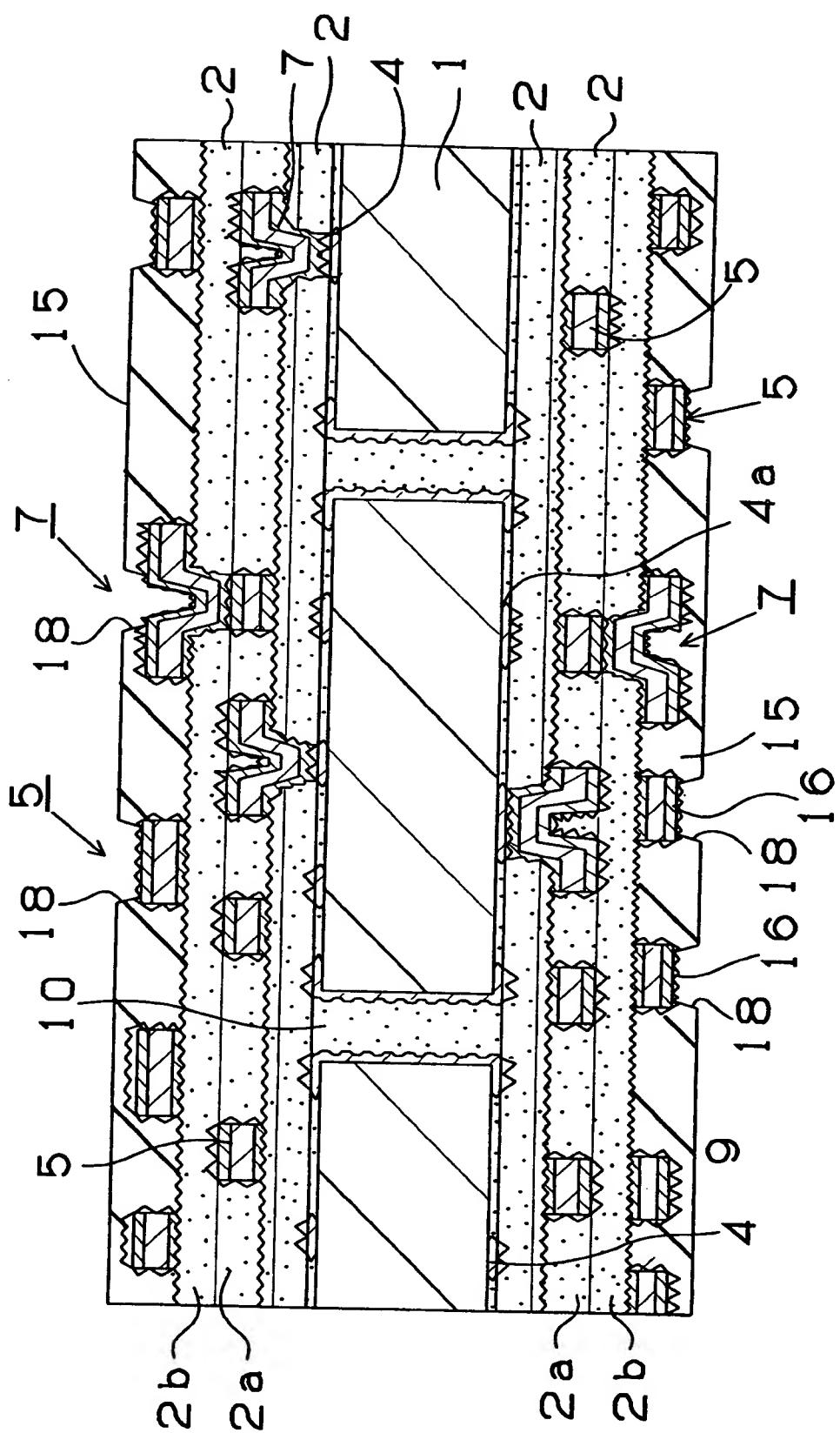
【図4】



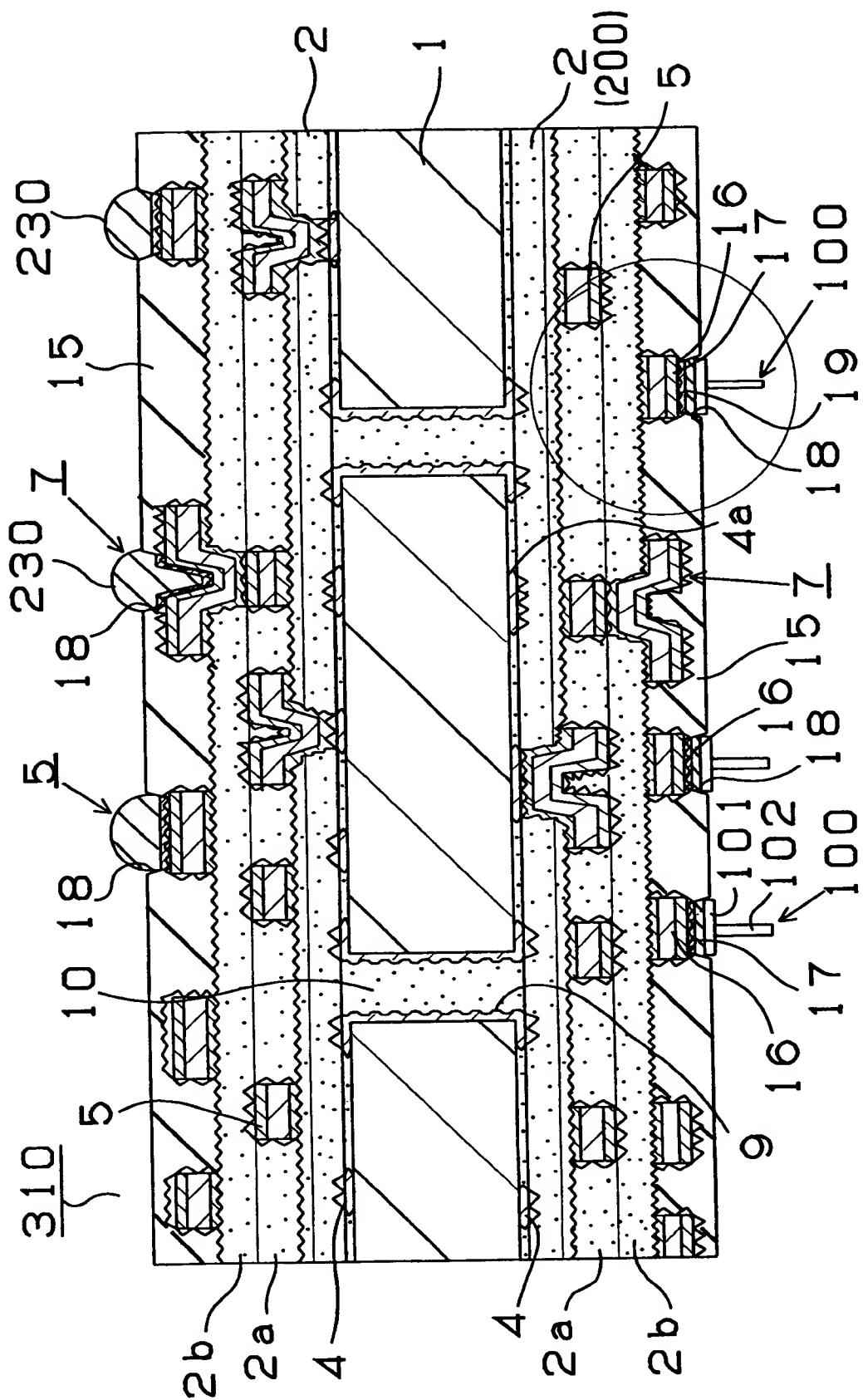
【図5】



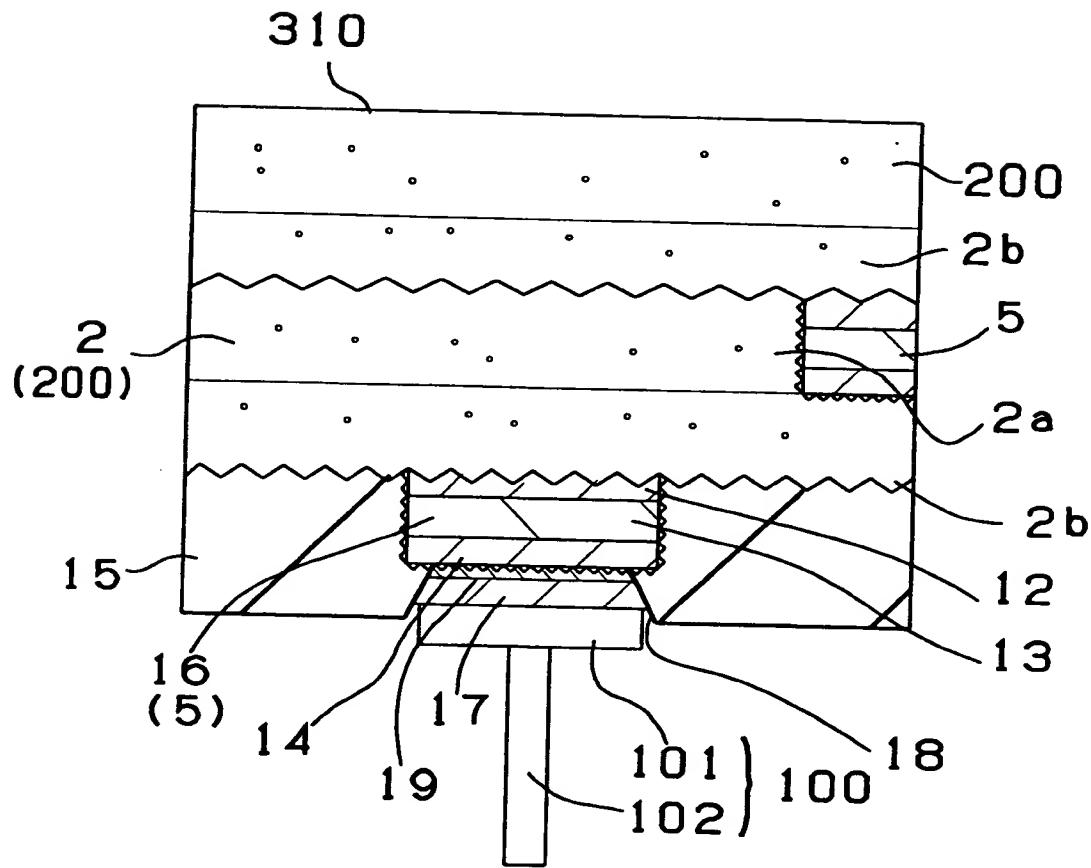
【図6】



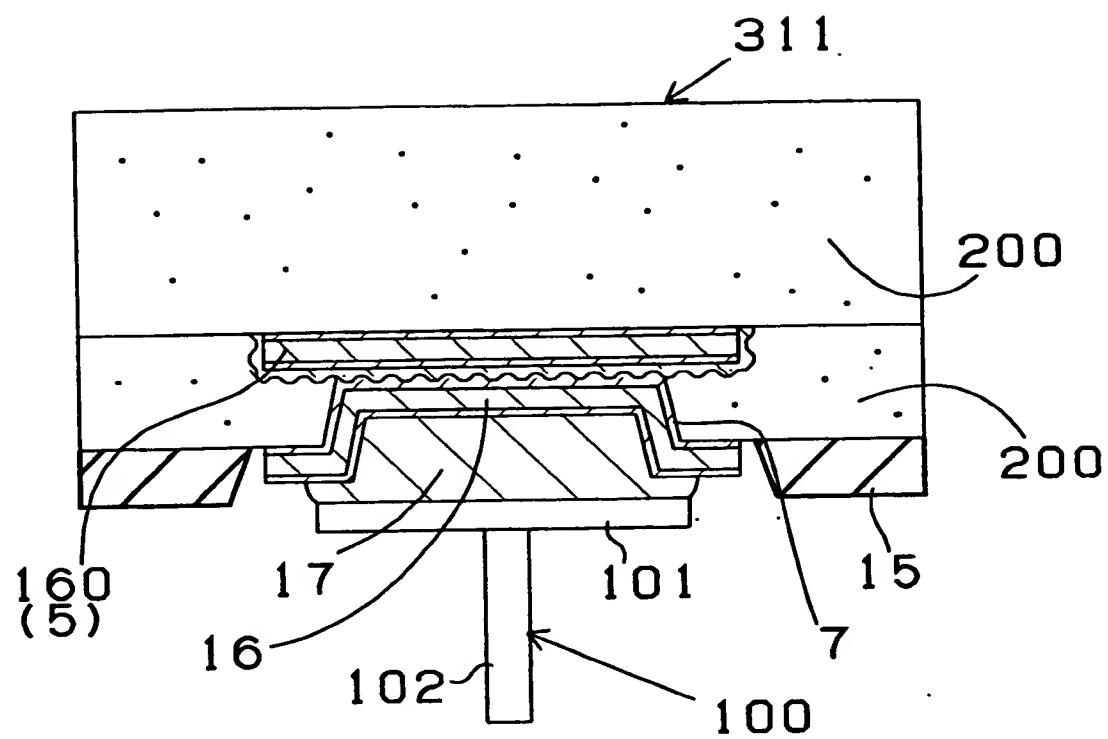
【図7】



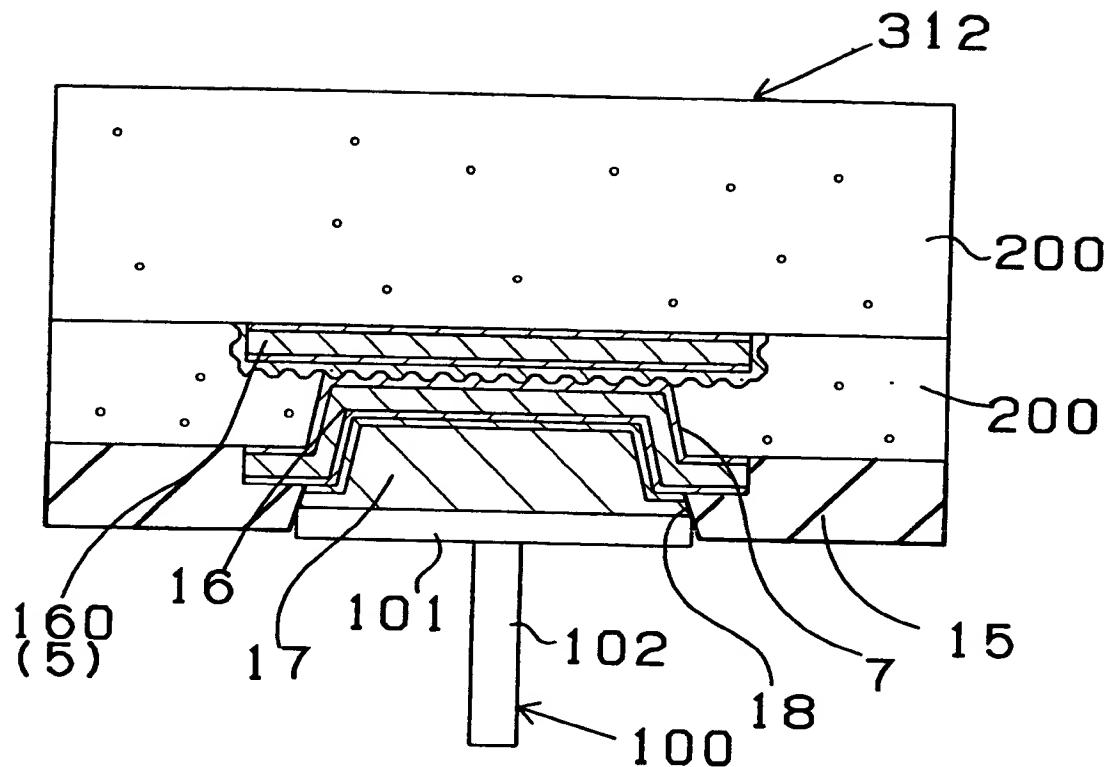
【図8】



【図9】

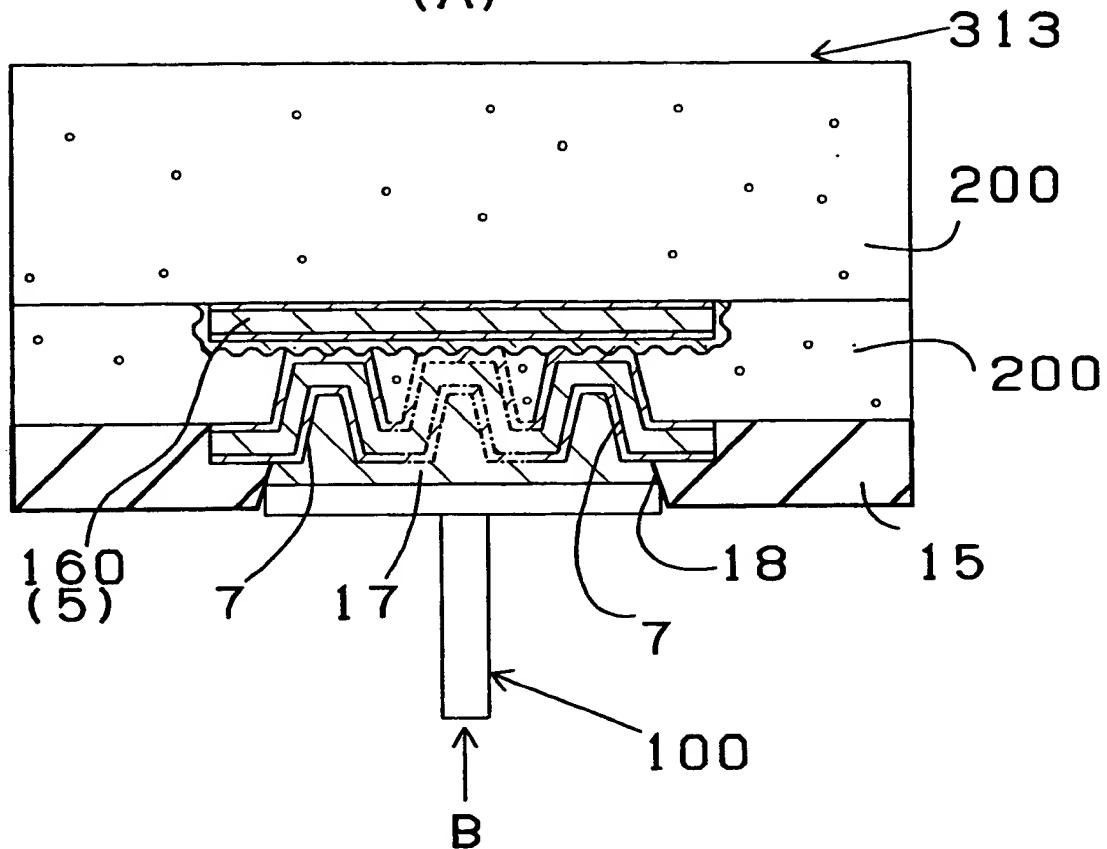


【図10】

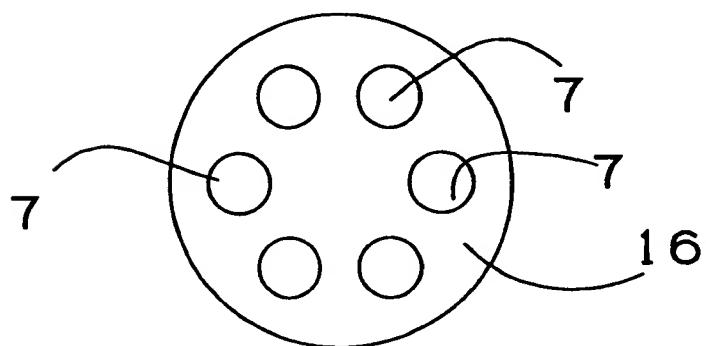


【図11】

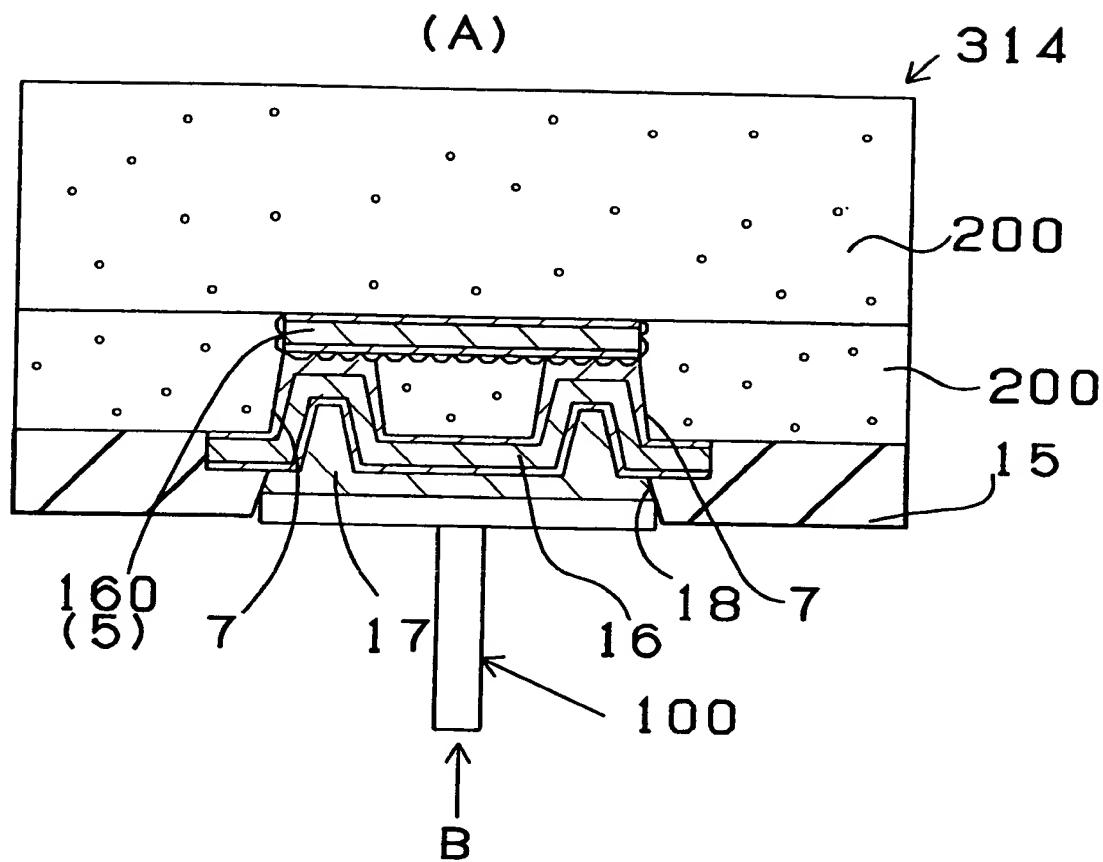
(A)



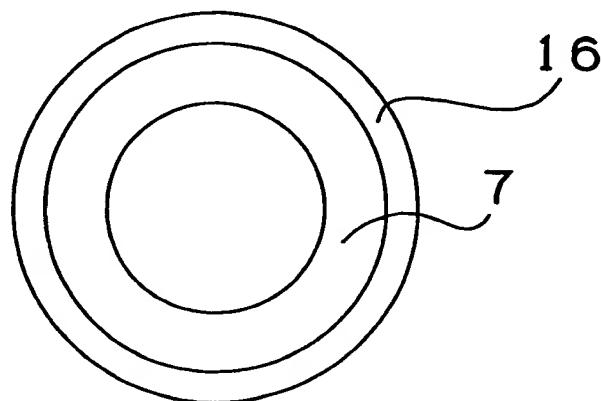
(B)



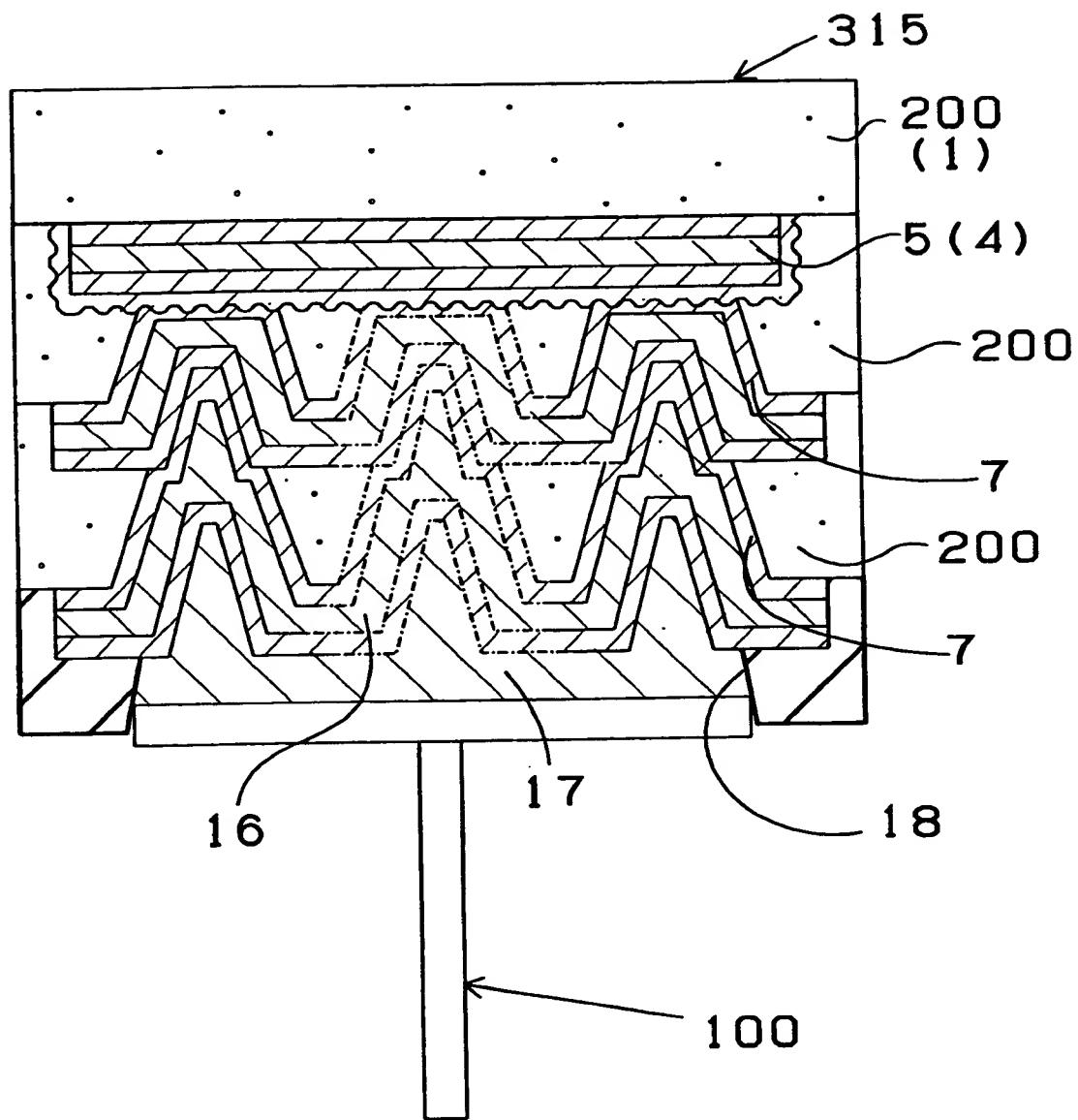
【図12】



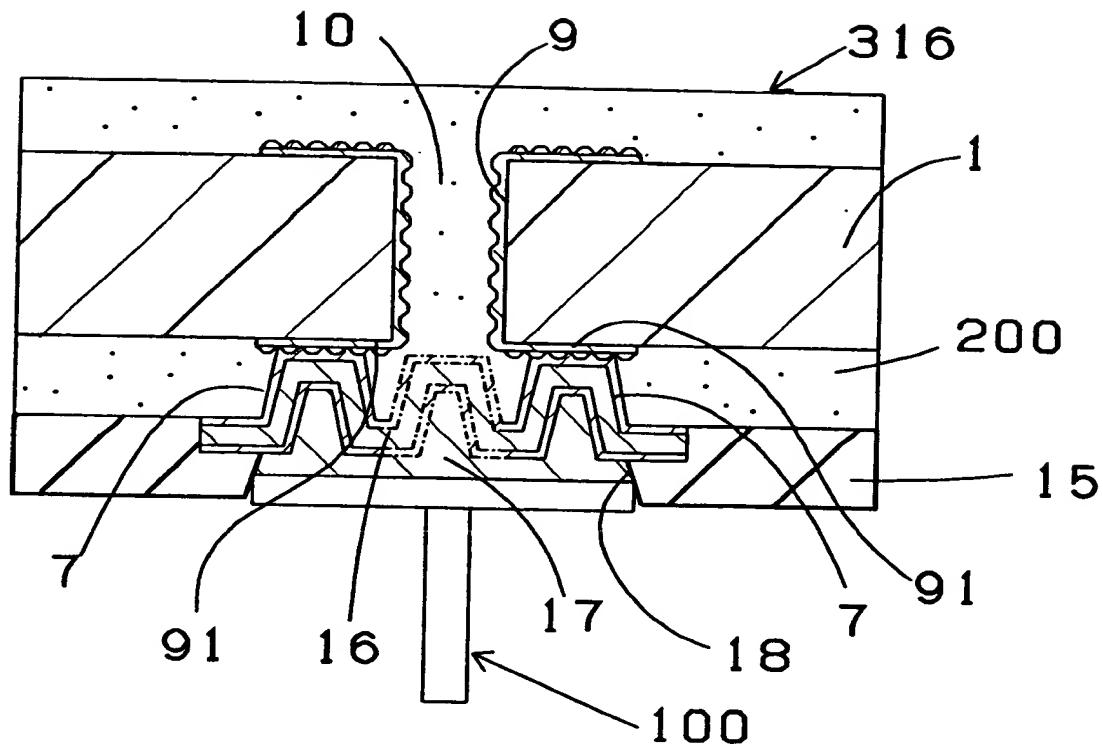
(B)



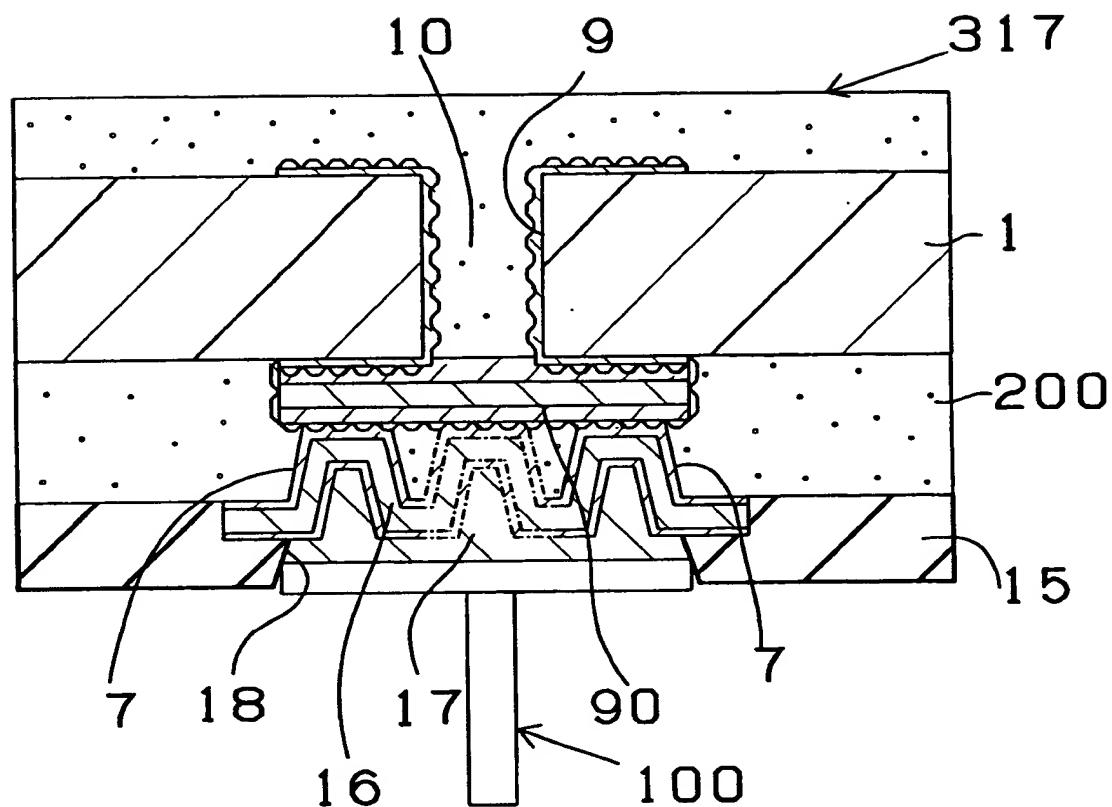
【図13】



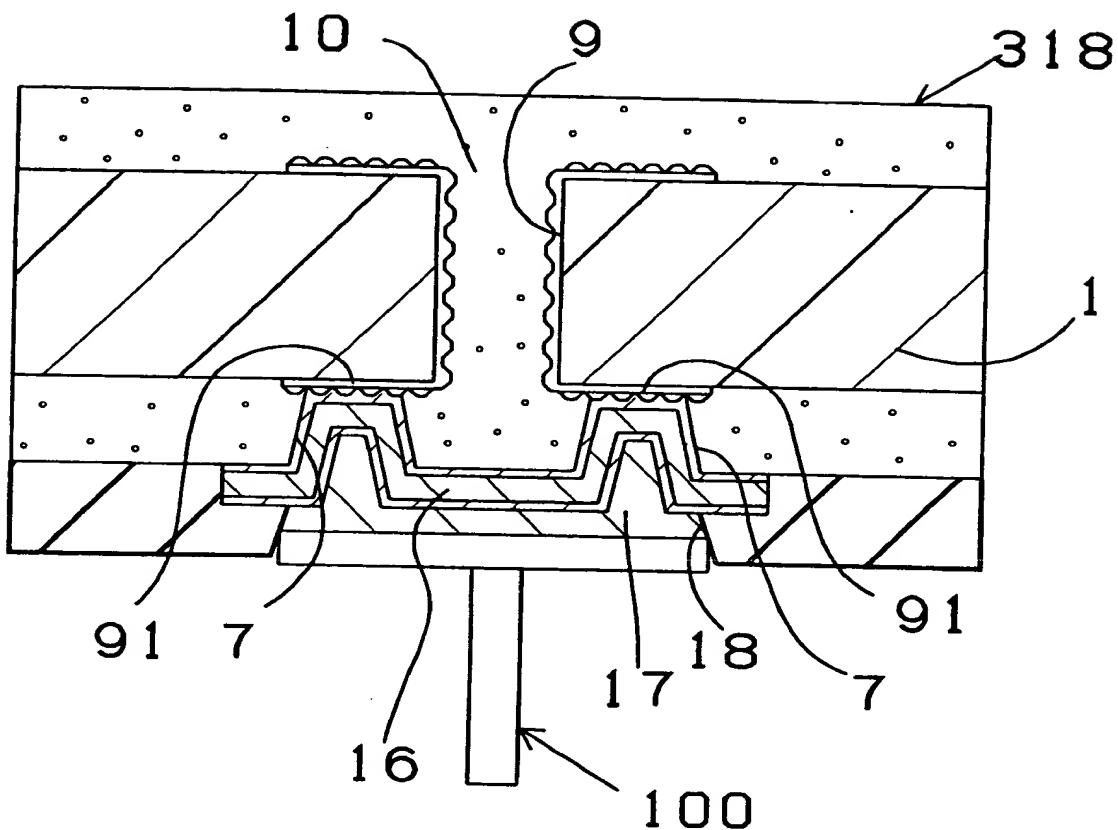
【図14】



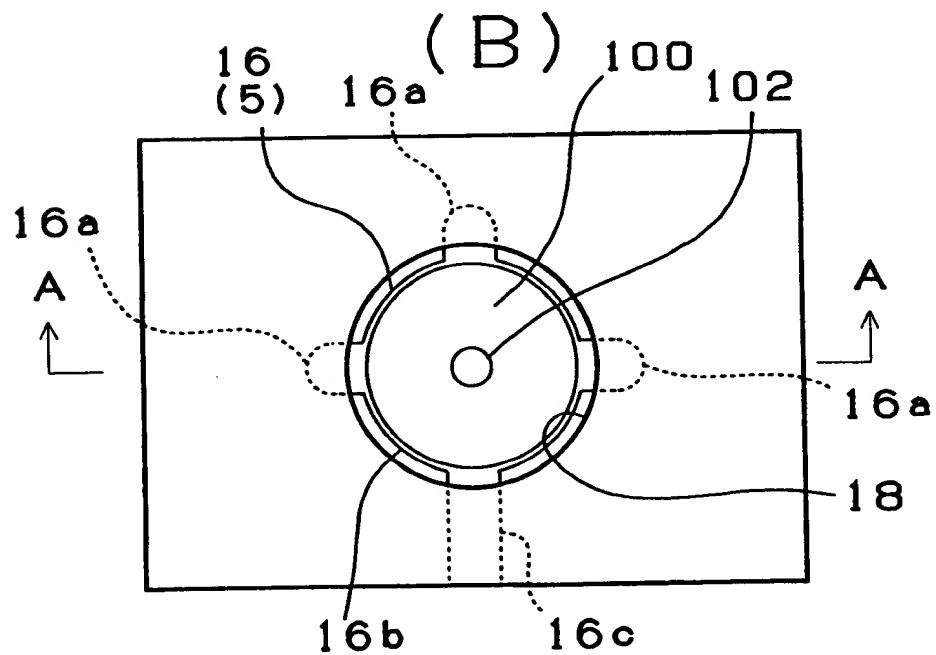
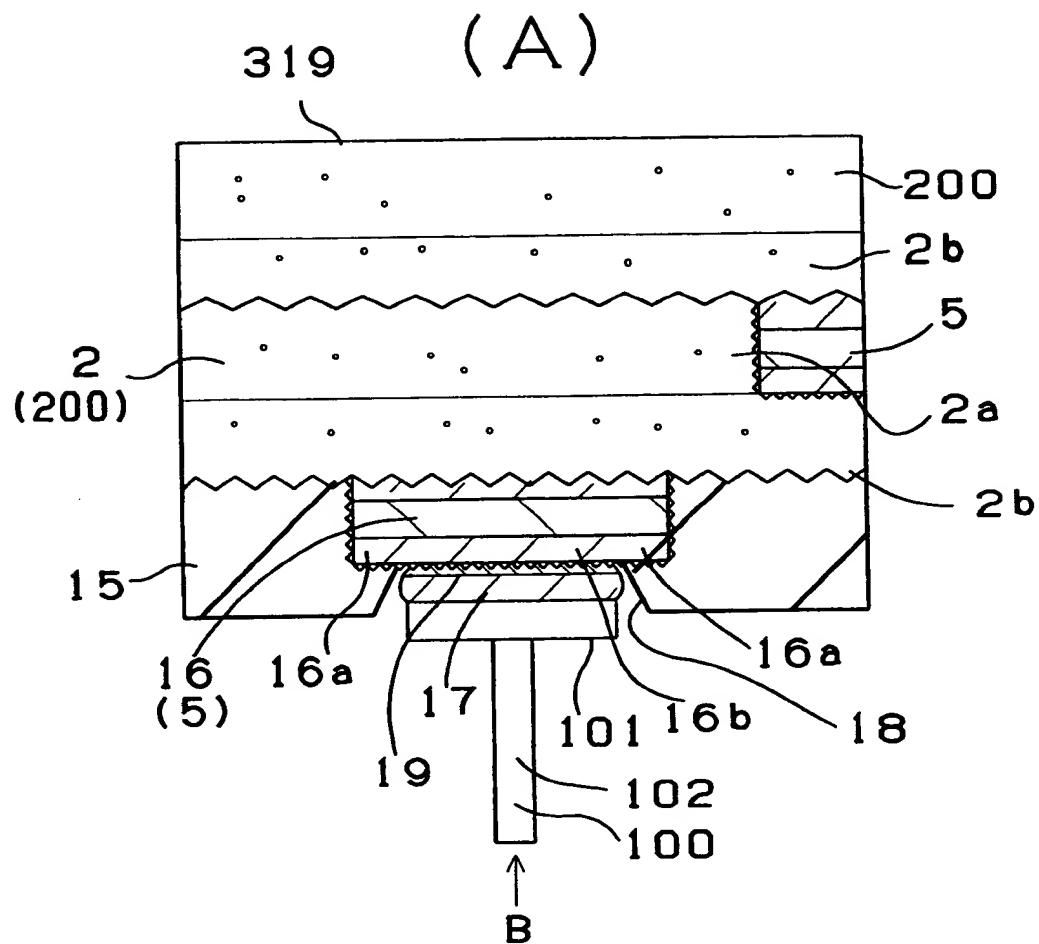
【図15】



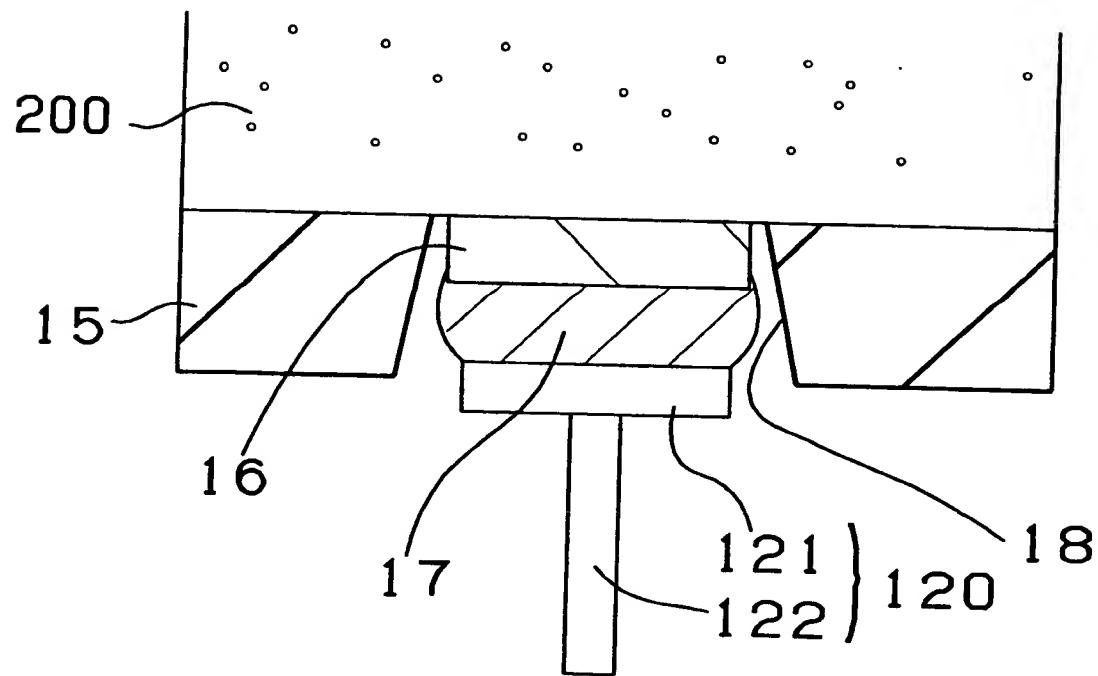
【図16】



【図17】



【図18】



【図19】

	導電性接続ピン		加熱試験後				ヒートサイクル試験後				
	接着強度		ピン状態	ピンの状態	接着強度		導通試験	ピンの状態	接着強度		
	最小値	平均値			最小値	平均値			最小値	平均値	
第1実施例	2.0	3.2	OK	OK	2.0	3.2	OK	OK	1.9	3.1	OK
第1実施例の第1改変例	2.0	3.0	OK	OK	2.0	3.0	OK	OK	1.9	2.9	OK
第2実施例	2.1	3.2	OK	OK	2.1	3.2	OK	OK	2.0	3.1	OK
第2実施例の第1改変例	2.1	3.5	OK	OK	2.1	3.5	OK	OK	2.0	3.4	OK
第2実施例の第2改変例	2.1	3.6	OK	OK	2.1	3.6	OK	OK	2.0	3.5	OK
第2実施例の第3改変例	2.1	3.5	OK	OK	2.1	3.5	OK	OK	2.0	3.4	OK
第2実施例の第4改変例	2.1	3.8	OK	OK	2.1	3.8	OK	OK	2.0	3.6	OK
第3実施例	2.0	3.0	OK	OK	2.0	3.0	OK	OK	1.9	2.9	OK
第3実施例の第1改変例	2.0	3.2	OK	OK	2.0	3.2	OK	OK	1.9	3.1	OK
第3実施例の第2改変例	2.0	3.2	OK	OK	2.0	3.2	OK	OK	1.9	3.1	OK
第4実施例	2.0	3.6	OK	OK	2.0	3.6	OK	OK	1.9	3.5	OK

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 導電性接続ピンが剥離し難い樹脂パッケージ基板を提供する。

【解決手段】 導体層5を設けた基板上に、マザーボードとの電気的接続を得るための導電性接続ピン100が固定されてなるパッケージ基板310に導電性接続ピンを固定するためのパッド16を形成する。パッド16を部分的に露出させる開口部18が形成された有機樹脂絶縁層15で被覆し、開口部から露出したパッドに導電性接続ピン100を導電性接着剤17により固定することにより、実装の際などに、導電性接続ピン100を基板から剥離しにくくする。

【選択図】 図7

出願人履歴情報

識別番号 [00000158]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

氏 名 イビデン株式会社